

Question de cours : Analogie entre le champ électrostatique et le champ gravitationnel

Expression des forces d'interaction, des champs et des potentiels associés. Théorème de Gauss pour le champ gravitationnel.

Exercice : Champ dans une cavité cylindrique

Un cylindre infini d'axe O_1z possédant une charge volumique uniforme ρ , présente une cavité cylindrique infinie (d'axe O_2z avec O_2 différent de O_1) vide de charges.

1. Déterminer l'expression du champ électrostatique pour un cylindre infini plein, d'axe Oz , de charge volumique uniforme ρ .
2. Montrer que le champ électrostatique est uniforme dans la cavité du cylindre creux. Déterminer son expression.

Question de cours : Condensateur plan

On admet l'expression de champ électrostatique créé par un plan infini chargé uniformément en $z = 0$ ($\vec{E} = \pm \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{u}_z$). Champ créé par un condensateur plan. Capacité d'un condensateur plan. Aspect énergétique.

Exercice : Distribution volumique entre deux sphères concentriques

On considère une charge q positive répartie en volume entre deux sphères concentriques de rayon R_1 et R_2 . On appelle $\rho(r)$ la densité volumique de charges entre R_1 et R_2 . Le champ électrostatique se met sous la forme : $\vec{E}(r) = a(r - R_1)\vec{u}_r$ pour $R_1 \leq r \leq R_2$ avec a une constante. On donne, pour un champ à symétrie sphérique :

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{dE_r}{dr} + \frac{2E_r}{r} \quad \text{avec} \quad E_r = \vec{E} \cdot \vec{u}_r$$

1. Déterminer $\rho(r)$ en fonction de a , r , R_1 et ϵ_0 .
2. Déterminer a en fonction de q , ϵ_0 , R_1 et R_2 .
3. Déterminer le champ électrostatique en tout point de l'espace. Représenter graphiquement E_r en fonction de r .

Question de cours : Boule uniformément chargée

Déterminer l'énergie de constitution d'une boule uniformément chargée en la construisant par adjonction progressive de charges apportées de l'infini.

Exercice : Modélisation de la jonction PN d'une diode ou d'un transistor

Lorsqu'un semi-conducteur présente, dans une région très localisée de l'espace, une variation très brutale de la concentration en dopant, voire un changement de la nature du dopant, on dit qu'on a une jonction. Au voisinage de la jonction, dans une région dite « zone de charge », le cristal acquiert une distribution de charge électrique non nulle que l'on se propose d'étudier. Les propriétés qui en résultent sont à la base de la caractéristique de diodes, des transistors et de tous les circuits intégrés (ampli op en particulier).

1. On considère un plan infini d'équation $z = 0$, portant une densité surfacique de charge σ constante. Ce plan est plongé dans un milieu quasi-isolant dans lequel la permittivité électrique est $\epsilon_r \epsilon_0$. Déterminer le champ électrique créé en tout point de l'espace en utilisant le théorème de Gauss.

On se place dans le germanium, de permittivité relative ϵ_r et on suppose que la densité volumique de charge ρ invariante en x et en y autour d'une jonction située dans le plan $z = 0$ a l'allure de la figure 1 :

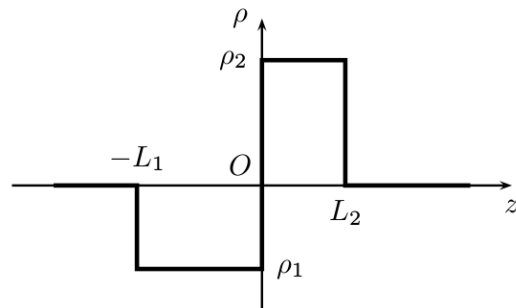


FIGURE 1 – Modélisation volumique de la jonction PN

2. Sachant que la distribution de charge est globalement neutre, établir la relation vérifiée par L_1 , L_2 , ρ_1 et ρ_2 .
3. Déterminer le champ électrique en tout point M de l'espace. On utilisera le fait que le champ électrique est nul pour un point M situé à l'infini.
4. En déduire le potentiel électrostatique $V(M)$. On choisira l'origine des potentiels en $z = 0$.
5. Représenter $V(z)$.
6. Donner l'expression de la différence de potentiel V_0 entre deux points situés de part et d'autre de la zone de charge.
7. La région ($z > 0$) a été dopée avec de l'antimoine à raison de $N_2 = 1,6 \times 10^{21}$ atomes Sb par m^3 , tandis que la région ($z < 0$) a été dopée avec du bore, avec un nombre d'atomes $N_1 \gg N_2$. On admet que dans la zone de charge, chaque atome Sb est ionisé en Sb^+ . Les électrons ainsi libérés traversent spontanément le plan $z = 0$ et chaque atome de bore situé dans la zone de charge se transforme en un anion B^- . En déduire ρ_1 et ρ_2 en fonction de N_1 et N_2 .
8. Le système ainsi constitué est une diode à jonction dont la tension de seuil est voisine de V_0 . En déduire une expression approchée de la largeur δ de la zone de charge.
9. Application numérique : calculer δ ; on donne : $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ F.m $^{-1}$; $\epsilon_r = 16$; $V_0 = 0,3$ V et $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.

Question de cours : Dipôle électrostatique

Description. Potentiel créé. Champ créé.

Distribution sphérique non homogène

En coordonnées sphériques, on considère une distribution de charges à symétrie sphérique, définie par :

$$\begin{cases} \rho(r) = \rho_0 R/r & \text{pour } r \in [0, R]; \\ \rho(r) = 0 & \text{pour } r \in [R, \infty[\end{cases}$$

1. Déterminer la charge $Q(r)$ contenue dans la sphère de centre O et de rayon r pour $r \in [0, \infty[$.
2. Déterminer le champ électrique \vec{E} et le potentiel V en tout point de l'espace.
3. Calculer l'énergie électrostatique de cette distribution de charges.

Question de cours : Dipôle électrostatique

Description. Potentiel créé. Champ créé.

Distribution sphérique non homogène

On considère le champ électrique d'expression en coordonnées sphériques

$$\begin{cases} \vec{E} = \frac{E_0 a^2}{2r^2} \vec{e}_r & \text{pour } r > a \\ \vec{E} = \frac{E_0}{2} \vec{e}_r & \text{pour } r < a \end{cases}$$

1. Décrire la distribution de charges électriques à l'origine de ce champ.
2. Déterminer le potentiel électrostatique correspondant.
3. Calculer l'énergie électrostatique du système.

Question de cours : Boule uniformément chargée

Déterminer l'énergie de constitution d'une boule uniformément chargée en la construisant par adjonction progressive de charges apportées de l'infini.

Systèmes à symétrie plane

L'espace est rapporté au repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

1. Soit une distribution de charges indépendante de y et z . Que peut-on dire du champ électrique créé par cette distribution de charges ?
2. Déterminer le champ électrique créé par un plan uniformément chargé de charge surfacique σ .
3. On étudie maintenant la distribution de charges :

$$\begin{cases} \rho(x) = \rho_0 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) & \text{pour } x \in]-a, a[; \\ \rho(x) = 0 & \text{pour } x \in]-\infty, -a[\cup]a, +\infty[\end{cases}$$

Déterminer le champ électrique \vec{E} et le potentiel V en tout point de l'espace.

Champs de révolution ; optique électronique

Soit une région vide de charges dans laquelle règne un champ électrique : $\vec{E} = E_r \vec{e}_r + E_z \vec{e}_z$ présentant la symétrie de révolution autour de l'axe Oz . Montrer que, au voisinage de l'axe : $E_r = -\frac{r}{2} \frac{\partial E_z}{\partial z}$.

Distribution sphérique non homogène

1. Pour $r \in [0, R]$, la charge $Q(r)$ contenue dans la sphère de centre O et de rayon r est

$$Q(r) = \int_0^r \frac{\rho_0 R}{r'} 4\pi r'^2 dr' = \rho_0 R \frac{4\pi r^2}{2} = 2\pi\rho_0 R r^2$$

Pour $r > R$, on a

$$Q(r) = Q(R) = 2\pi\rho_0 R^3$$

2. On applique le théorème de Gauss à la sphère de centre O et de rayon r ; on obtient

$$4\pi r^2 E(r) = \frac{Q(r)}{\epsilon_0}$$

soit

— pour $r < R$:

$$E(r) = \frac{\rho_0 R}{2\epsilon_0}$$

— pour $r > R$:

$$E(r) = \frac{\rho_0 R^3}{2\epsilon_0 r^2}$$

— pour $r \geq R$, la dérivée du potentiel est

$$V'(r) = -\frac{\rho_0 R^3}{2\epsilon_0 r^2}$$

En prenant l'origine des potentiels à l'infini, on obtient en intégrant

$$V(r) = \frac{\rho_0 R^3}{2\epsilon_0 r}$$

— pour $r \leq R$, la dérivée du potentiel est

$$V'(r) = -\frac{\rho_0 R}{2\epsilon_0}$$

En intégrant entre R et r , on obtient

$$V(r) - V(R) = -\frac{\rho_0 R(r - R)}{2\epsilon_0}$$

Le potentiel étant continu pour $r = R$, on a

$$V(R) = \frac{\rho_0 R^2}{2\epsilon_0}$$

soit

$$V(r) = \frac{\rho_0 R^2}{\epsilon_0} \left(1 - \frac{r}{2R}\right)$$

En récapitulant, on obtient

$$\begin{cases} \vec{E} = \frac{\rho_0 R}{2\epsilon_0} \vec{e}_r & \text{et } V(r) = \frac{\rho_0 R^2}{\epsilon_0} \left(1 - \frac{r}{2R}\right) & \text{pour } r \in [0, R]; \\ \vec{E} = \frac{\rho_0 R^3}{2\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & \text{et } V(r) = \frac{\rho_0 R^3}{2\epsilon_0 r} & \text{pour } r \in]R, \infty[\end{cases}$$

3. L'énergie électrostatique de cette distribution de charges peut se calculer par différentes méthodes.

— Première méthode : intégration de la densité volumique d'énergie électrostatique

$$\begin{aligned} U_E &= \frac{1}{2} \iiint \epsilon_0 E^2 d\tau \\ &= \frac{1}{2} \int_0^R \frac{\rho_0^2 R^2}{4\epsilon_0} 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2} \int_R^\infty \frac{\rho_0^2 R^6}{4\epsilon_0 r^4} 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{\pi \rho_0^2 R^2}{2\epsilon_0} \int_0^R r^2 dr + \frac{\pi \rho_0^2 R^6}{2\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{\pi \rho_0^2 R^2}{2\epsilon_0} \frac{R^3}{3} + \frac{\pi \rho_0^2 R^6}{2\epsilon_0} \frac{1}{R} \\ &= \frac{2\pi \rho_0^2 R^5}{3\epsilon_0} \end{aligned}$$

— Seconde méthode : intégration de l'énergie potentielle des charges constitutives

$$\begin{aligned} U_E &= \frac{1}{2} \iiint \rho(r) V(r) d\tau \\ &= \frac{1}{2} \int_0^R \frac{\rho_0 R}{r} \frac{\rho_0 R^2}{\epsilon_0} \left(1 - \frac{r}{2R}\right) 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{\rho_0^2 R^3}{2\epsilon_0} 4\pi \int_0^R \left(r - \frac{r^2}{2R}\right) dr \\ &= \frac{2\pi \rho_0^2 R^3}{\epsilon_0} \left[\frac{R^2}{2} - \frac{R^2}{6} \right] \\ &= \frac{2\pi \rho_0^2 R^5}{3\epsilon_0} \end{aligned}$$

Distribution sphérique non homogène

1. On utilise l'équation de Maxwell-Gauss.

— Pour $r > a$

$$\begin{aligned}\rho &= \epsilon_0 \operatorname{div} \vec{E} \\ &= \epsilon_0 E_0 a^2 \operatorname{div} \left(\frac{\vec{e}_r}{r^2} \right) \\ &= 0\end{aligned}$$

Il n'y a pas de charges à l'extérieur de la sphère de centre O et de rayon a .

— Pour $r = a$: le champ électrique est discontinu ; il y a donc une distribution de charges surfaciques dont on détermine la densité surfacique σ en utilisant la relation de passage

$$\vec{E}(a^+) - \vec{E}(a^-) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_r$$

On en déduit

$$\sigma = \epsilon_0 \frac{E_0}{2}$$

— Pour $r < a$

$$\begin{aligned}\rho &= \epsilon_0 \operatorname{div} \vec{E} \\ &= \frac{\epsilon_0 E_0}{2} \operatorname{div} \left(r^2 \frac{\vec{e}_r}{r^2} \right) \\ &= \frac{\epsilon_0 E_0}{2} \operatorname{grad} r^2 \cdot \frac{\vec{e}_r}{r^2} \\ &= \frac{\epsilon_0 E_0}{r}\end{aligned}$$

2. Le potentiel étant continu en $r = a$, il suffit d'examiner le domaine extérieur et le domaine intérieur.

— Pour $r > a$, on a $V'(r) = -\frac{E_0 a^2}{r^2}$ soit, en intégrant entre ∞ et r , et en prenant l'origine des potentiels à l'infini :

$$V(r) = E_0 \frac{a^2}{r}$$

— Pour $r < a$, on a $V'(r) = -\frac{E_0}{2}$ soit, en intégrant entre a et r :

$$V(r) = V(a) - \frac{E_0}{2}(r - a)$$

Le potentiel étant continu en $r = a$, on obtient

$$V(r) = E_0 a - \frac{E_0}{2}(r - a) = \frac{3E_0 a}{2} \left(1 - \frac{r}{3a} \right)$$

3. L'énergie électrostatique de cette distribution de charges peut se calculer par différentes méthodes.

— Première méthode : intégration de la densité volumique d'énergie électrostatique

$$\begin{aligned}U_E &= \frac{1}{2} \iiint \epsilon_0 E^2 d\tau \\ &= \frac{1}{2} \int_0^a \frac{\epsilon_0 E_0^2}{4} 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2} \int_a^\infty \frac{\epsilon_0 E_0^2 a^4}{r^4} 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{\pi \epsilon_0 E_0^2}{2} \int_0^a r^2 dr + 2\pi \epsilon_0 E_0^2 a^4 \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{\pi \epsilon_0 E_0^2}{2} \frac{a^3}{3} + 2\pi \epsilon_0 E_0^2 a^4 \frac{1}{a} \\ &= \frac{13}{6} \pi \epsilon_0 E_0^2 a^3\end{aligned}$$

— Seconde méthode : intégration de l'énergie potentielle des charges constitutives

$$\begin{aligned}U_E &= \frac{1}{2} \iiint \rho(r) V(r) d\tau + \frac{1}{2} \iint \sigma V(a) dS \\ &= \frac{1}{2} \int_0^a \frac{\epsilon_0 E_0}{r} \frac{3E_0 a}{2} \left(1 - \frac{r}{3a} \right) 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{E_0}{2} 4\pi a^2 E_0 a \\ &= 3\pi \epsilon_0 E_0^2 a \int_0^a \left(r - \frac{r^2}{3a} \right) dr + \pi \epsilon_0 E_0^2 a^3 \\ &= 3\pi \epsilon_0 E_0^2 a \left[\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{9} \right] + \pi \epsilon_0 E_0^2 a^3 \\ &= \frac{13}{6} \pi \epsilon_0 E_0^2 a^3\end{aligned}$$

Systèmes à symétrie plane

1. Le champ électrique est invariant par translation selon \vec{e}_y et selon \vec{e}_z . Le champ électrique ne dépend donc que de x . M étant un point quelconque de l'espace, les plans $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$ et $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ sont des plans de symétrie. $\vec{E}(M)$ doit donc être parallèle à chacun de ces plans. Il est donc dirigé selon \vec{e}_x . Au final, on peut écrire

$$\vec{E}(M) = E(x)\vec{e}_x$$

2. Choisissons \vec{e}_x comme vecteur normal au plan chargé. On peut alors utiliser le résultat établi précédemment, soit

$$\vec{E}(M) = E(x)\vec{e}_x$$

Choisissons $x = 0$ sur le plan. Ce plan est un plan de symétrie. La fonction $E(x)$ est donc impaire. L'équation de Maxwell-Gauss donne

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = 0 \text{ pour } x > 0 \\ \operatorname{div} \vec{E} = 0 \text{ pour } x < 0 \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} E'(x) = 0 \text{ pour } x > 0 \\ E'(x) = 0 \text{ pour } x < 0 \end{cases}$$

En intégrant, on obtient

$$\begin{cases} E(x) = E_+ \text{ pour } x > 0 \\ E(x) = E_- \text{ pour } x < 0 \end{cases}$$

E_+ et E_- sont deux constantes d'intégration ; la fonction $E(x)$ étant impaire, $E_- = -E_+$; on détermine alors E_+ en utilisant la relation de passage à la traversée du plan chargé.

$$\vec{e}_x \cdot (E_+\vec{e}_x - (-E_+\vec{e}_x)) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

On en déduit

$$E_+ = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \text{ soit } \begin{cases} \vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{e}_x \text{ pour } x > 0 \\ \vec{E} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{e}_x \text{ pour } x < 0 \end{cases}$$

3. L'équation de Maxwell-Gauss donne

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = 0 & \text{pour } x > a \\ \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) & \text{pour } |x| < a \\ \operatorname{div} \vec{E} = 0 & \text{pour } x < -a \end{cases}$$

soit

$$\begin{cases} E'(x) = 0 & \text{pour } x > a \\ E'(x) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) & \text{pour } |x| < a \\ E'(x) = 0 & \text{pour } x < -a \end{cases}$$

En intégrant, on obtient

$$\begin{cases} E(x) = E_+ & \text{pour } x > a \\ E(x) = E(0) + \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(x - \frac{x^3}{3a^2}\right) & \text{pour } |x| < a \\ E(x) = E_- & \text{pour } x < -a \end{cases}$$

Le plan d'équation $x = 0$ est un plan de symétrie pour les charges ; c'est donc un plan de symétrie pour le champ électrique. La fonction $E(x)$ est donc impaire, ce qui impose $E(0) = 0$.

Cette distribution est volumique ; le champ électrique est donc continu en $x = \pm a$; on peut donc éliminer E_+ par

$$E_+ = E(a) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(a - \frac{a^3}{3a^2}\right) = \frac{2\rho_0}{3\epsilon_0}$$

La parité donne alors $E_- = -E_+$. On a donc finalement

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{2\rho_0}{3\epsilon_0}\vec{e}_x & \text{pour } x > a \\ \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(x - \frac{x^3}{3a^2}\right)\vec{e}_x & \text{pour } |x| < a \\ -\frac{2\rho_0}{3\epsilon_0}\vec{e}_x & \text{pour } x < -a \end{cases}$$

Champs de révolution ; optique électronique

Le champ présentant la symétrie de révolution, on a

$$\vec{E} = E_r(r, z)\vec{e}_r + E_z(r, z)\vec{e}_z$$

La composante radiale s'annule en $r = 0$. On peut donc l'écrire sous la forme

$$E_r(r, z) = ru(z)$$

en se limitant à l'ordre 1 en r . La divergence du champ électrique est

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \vec{E} &= \operatorname{div} (ru(z)\vec{e}_r) + \operatorname{div} (E_z(r, z)\vec{e}_z) \\ &= \operatorname{grad} u(z) \cdot r\vec{e}_r + u(z) \operatorname{div} (r\vec{e}_r) + \varepsilon E_z(r, z)z \\ &= 2u(z) + \varepsilon E_z(r, z)z\end{aligned}$$

La divergence du champ électrique est nulle, donc

$$u(z) = -\frac{1}{2}\varepsilon E_z(r, z)z$$

On en déduit

$$E_r(r, z) = ru(z) = -\frac{r}{2}\varepsilon E_z(r, z)z$$